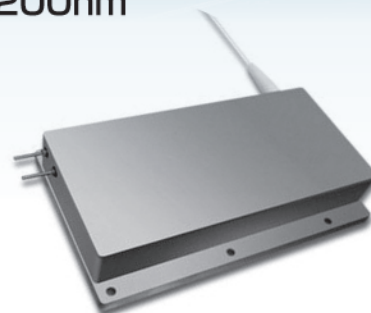
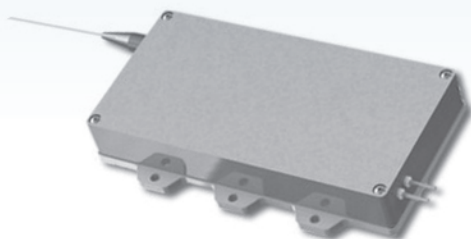


- 低プロファイルパッケージ (高さ: 15mm)
- 波長安定化線幅: <1 nm
- フィードバックアイソレーション: >30dB @ 1030-1200nm



915nm / 150W High Brightness Pump Diodes 高輝度マルチシングルエミッター

915nm / 940nm / 976nm : 200W (200 μ m NAO.22)
 915nm : 140W (105 μ m NAO.15)
 940nm : 120W (105 μ m NAO.22)
 976nm : 100W (105 μ m NAO.22)

976nm / 10W-180W High Brightness Wavelength Stabilized 波長安定化(VBG)マルチシングルエミッター

976nm : 180W (200 μ m NAO.22)
 976nm : 80W (105 μ m, NAO.15)



BJP (Beijing Jiepu Trend Technology) は1998年に設立し、結晶成長、ボンディング、コーティングを一括して行っております。特にCr⁴⁺:YAGは初期透過率: 1-98%まで対応、他の結晶とボンディングしたものやアンドープ結晶とのボンディングなど様々な状態で提供します。ボンディング結晶はサイズ、組み合わせ、ドープ率などすべてご指定いただけます。全ての結晶は1個から提供可能です。

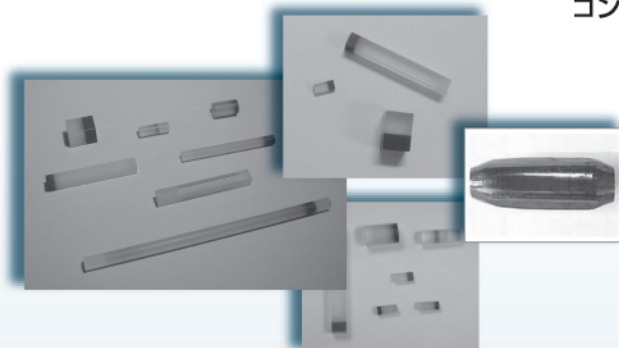
コンポジットレーザー結晶 & Cr⁴⁺:YAGパッシブQスイッチ結晶



自社製造結晶リスト

Cr ⁴⁺ :YAG	Yb:YAG	YAG
Nd:YAG	Nd:YVO ₄	YVO ₄
Er:YAG	Nd:YLF	
Nd:Ce:YAG	Nd:GGG	

コンポジット結晶例



Material	Doping Concentration (atm) or Optical Density (cm ⁻¹)	Aperture (mm)	Length (mm)
YAG+Nd:YAG	0.6~1.2%	2x2~20x20	2~200
YAG+Cr ⁴⁺ :YAG	0.6~7	2x2~20x20	2~50
Nd:YAG+Cr ⁴⁺ :YAG	0.6~1.2%/0.6~7	2x2~20x20	2~200
YAG+Nd:YAG+YAG	0.6~1.2%	2x2~20x20	3~200
YAG+Nd:YAG+Cr ⁴⁺ :YAG	0.6~1.2%/0.6~7	2x2~20x20	3~200
YAG+Nd:YAG+Cr ⁴⁺ :YAG+YAG	0.6~1.2%/0.6~7	2x2~20x20	5~200
YAG+Cr ⁴⁺ :YAG+Nd:Ce:YAG+YAG	0.6~7/Nd0.9~1.3%Ce:Nd=1:10	2x2~10x10	5~130
YVO ₄ +Nd:YVO ₄ +YVO ₄	0.1~3%	2x2~10x10	1~20
YVO ₄ +Nd:YVO ₄ +YVO ₄	0.1~3%	Dia.2~10	3~20

日本販売元・お問い合わせ先



Broadband, Inc
<http://www.bblaser.com/>

〒121-0832 東京都足立区古千谷本町4-7-9

TEL: 03-5838-0082 FAX: 03-5838-0083 E-mail: ask@bblaser.com